



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**HS13003**

A1

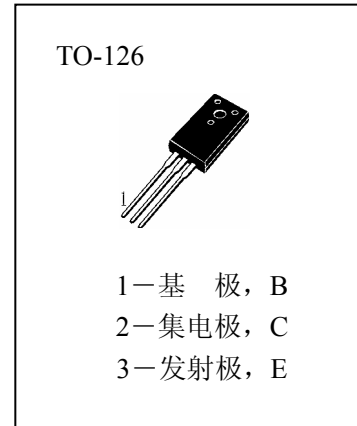
■ 主要用途

高压快速开关

■ 极限值 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

$T_{stg}$ ——贮存温度	.....	-65~150 $^\circ\text{C}$
$T_j$ ——结温	.....	150 $^\circ\text{C}$
$P_C$ ——集电极耗散功率 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	.....	30W
$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压	.....	600V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压	.....	400V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压	.....	9V
$I_C$ ——集电极电流 (DC)	.....	1.5A

■ 外形图及引脚排列



■ 电参数 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$V_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	600			V	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$
$V_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=10\text{mA}, I_B=0$
$V_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	9			V	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	10		40		$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.1\text{A}$
$V_{CE}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压			0.8	V	$I_C=1\text{A}, I_B=500\text{mA}$
				0.8	V	$I_C=0.5\text{A}, I_B=100\text{mA}$
$V_{BE}(\text{sat})$	基极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_C=0.5\text{A}, I_B=100\text{mA}$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			10	$\mu\text{A}$	$V_{CB}=500\text{V}, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			10	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$
$f_T$	特征频率	8			MHz	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.1\text{A}, f=1\text{MHz}$
$t_{ON}$	导通时间			1.1	$\mu\text{S}$	$V_{CC}=125\text{V}, I_C=1\text{A}$ $I_{B1}=0.2\text{A}, I_{B2}=-0.2\text{A}$ $R_L=125\Omega$
$t_{STG}$	贮存时间			4.0	$\mu\text{S}$	
$t_F$	下降时间			0.7	$\mu\text{S}$	

■ 分档及其标志

H1	H2	H3	H4	H5
10-16	14-21	19-26	24-31	29-40